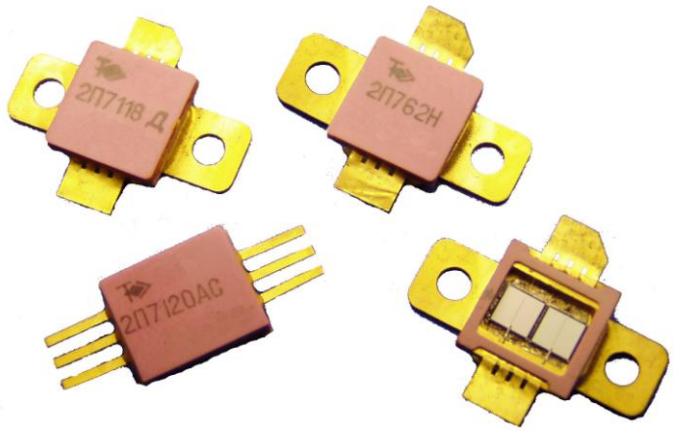
КРЕМНИЕВЫЕ МОЩНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ МДП и БТИЗ ТРАНЗИСТОРЫ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Транзисторы обладают высокими эксплуатационными характеристиками, применяются в малогабаритных вторичных источниках питания наземной и бортовой авиационной и ракетно-космической техники.



Тип изделия	$U_{си}$	$I_{с\ макс}$	$R_{си\ (откр)}$	$P_{макс}$	Корпус
	В	А	Ом	Вт	
2П701А (А842А)	500	5	3.5	40	КТ-57
2П701Б (А842Б)	400	5	2.8	40	КТ-57
2П803А (А843А)	1000	2.6	5	60	КТ-57
2П803Б (А843Б)	800	3	4.5	60	КТ-57
2П762А (А874)	100	100 (имп.)	0,085	80	КТ-57
2П762Д (А874)	150	30 (имп)	0,1	80	КТ-57
2П762Н (А874)	200	80 (имп)	0,2	80	КТ-57

Тип изделия	$U_{си\ макс}$	$U_{зи\ пор}$	$I_{с\ max}$/ $I_{с\ и\ max}$	$R_{си\ (откр)}$	$I_{с\ нач}$	$I_{з,ут.}$	$P_{макс}$	Корпус
	В	В	А	Ом	мА	А	Вт	
2П7118А	30	1,5÷5,0	35/100	0,025	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 Б	40	1,5÷5,0	35/100	0,035	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57

2П7118 В	50	1,5÷5,0	35/100	0,04	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 Г	60	1,5÷5,0	30/100	0,05	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 Д	100	1,5÷5,0	30/100	0,075	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 Е	100	1,5÷5,0	30/100	0,085	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 Ж	150	1,5÷5,0	25/100	0,1	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 И	150	1,5÷5,0	25/100	0,12	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 К	200	1,5÷5,0	20/100	0,16	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118 Л	200	1,5÷5,0	20/100	0,2	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57

Кремниевые биполярные транзисторы с изолированным затвором (БТИЗ)

Тип изделия	U_{GES}	I_C	$U_{GE(ON)}$	$P_{макс}$	$\tau_{вкл.}$	$\tau_{выкл.}$	Корпус
	V	A	В	Вт	нсек	нсек	
2Е701А	700	25	2.5	75	200	700	КТ-57
2Е701Б	500	25	2.5	7 5	200	500	КТ-57
2Е701В	500	25	2.5	75	200	500	КТ-57
2Е701Г	700	25	2.5	75	200	700	КТ-57

Транзисторная сборка кремниевых эпитаксиально-планарных полевых изолированным затвором мощных с изолированным затвором переключательных транзисторов

Тип изделия	$U_{си\ макс}$	$I_{з,ут.}$	$R_{си\ (откр\ )*}$	$I_{с\ нач}$	$U_{зи\ пор}$	$I_с$	$U_{пр.}/\ t_{восст.}$ **	Корпус
	В	А	Ом	мА	В	А	В/нс	
2П7120 АС	150	**$3 \cdot 10^{-7}$**	0,2	**2,0**	**2,0**	5,0	3,0/500	427.8-1
2П7120 БС	200	**$3 \cdot 10^{-7}$**	0,5	**2,0**	**4,0**	5,0	3,0/500	427.8-1
2П7120 ВС	150	**$3 \cdot 10^{-7}$**	0,2	**2,0**	**2,0**	5,0	3,0/500	427.8-1
2П7120 ГС	200	**$3 \cdot 10^{-7}$**	0,5	**2,0**	**4,0**	5,0	3,0/500	427.8-1
2П7120 ДС	150	**$3 \cdot 10^{-7}$**	0,2	**2,0**	**2,0**	5,0	3,0/50	427.8-1
2П7120 ЕС	200	**$3 \cdot 10^{-7}$**	0,5	**2,0**	**4,0**	5,0	3,0/50	427.8-1

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ СЕРИИ 1474 ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРНЫХ КЛЮЧЕЙ

Область применения: интеллектуальная силовая электроника специального и обще¬гражданского применения (устройства промышленной авто¬матики, преобразования и распределения электроэнергии, ис¬точники питания, приводы электродвигателей, бытовая техни¬ка) ИМС типа 1474АП1Т предназначены для управления силовыми транзисторными ключами (СТК) на основе МДП и БТИЗ.

Основные особенности:

двухполярное напряжение питания, что позволяет эффективно управлять силовыми ключами на МДП и БТИЗ;	**наличие внутреннего реле напряжения питания, что обеспечивает надежную эксплуатацию силовых модулей;**
возможность введения регулируемой задержки включения, что исключает возникновение сквозных	**микросхема «активно» удерживает выходной потенциал на низком уровне, даже при отсутствии питания, что**

токов в мостовых иполумостовых регуляторах и преобразователях;	**обеспечивает безопасность переходных режимов «включение и выключение силовых модулей».**
наличие трех управляющих входов (потенциального, токового и оптронного);	

Конструктивно ИМС 1474АП1Т выполнены в металлокерамическом корпусе 402.16-34, возможна поставка микросхем в корпусе 4112.16-3 и в бескорпусном исполнении – модификация 4 ОСТ В 11 073.067-82.

Электрические параметры ИМС 1474АП1Т

Наименование параматра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	норма	
		не менее	не более
1.Входное напряжение высокого уровня, В	U_{OH}	8	U_{CC1}
2.Входное напряжение низкого уровня,В	U_{OL}		1
3.Входное напряжениеключения драйвера(по потенциальному входу), В	U_{IH}	2,5	15
4.Входное напряжениеключения драйвера(по потенциальному входу), В	U_{IL}		0,5
5.Входной ток включения драйвера(по таковому входу),мА	I_{IH}	1,5	2,5
6.Входной ток включения драйвера(по таковому входу),мА	I_{IL}		0,1
7.Средний статический ток потребления, мА	I_{CCAV}		15
8.Время нарастания (спада) выходного напряжения, нс при CL = 12000 пФ RL = 1,0 Ом (послед.) - при однополярном питании - при двухполярном питании	$t_r(t_f)$		150 200
9.Время задержки включения (выключения), нс при CL = 12000 пФ, RL = 1,0 Ом	$t_{DHL}(t_{DLH})$		70